

Identification of Mn dopant in the structure of TlInS 2 layered semiconductor

Okumuş Esra¹, Ozturk Sibel Tokdemir¹, Chumakov Yuri¹, Nadjafov Arzu², Mamedov N.², Mammadov T.², Wakita Kazuki³, Shim Yonggu⁴, Mikailzade Faik A.¹, Seyidov Mir Hasan Yu¹

¹ Gebze Technical University,

² Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences,

³ Chiba Institute of Technology,

⁴ Osaka Prefecture University

Materials Research Express

Nr. 5(6) / 2019 / ISSN - / ISSNNe 2053-1591

Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-729

Особенности радиотермолюминесценции гамма-облученных боросиликатов

Меликова С., Гарибов А., Гаджиева Н., Наджафов А.

Институт радиационных проблем НАН Азербайджана

Электронная обработка материалов

Nr. 4(49) / 2013 / ISSN 0013-5739 / ISSNNe 2345-1718

Disponibil online 28 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-925

Анизотропия электропроводности в облученных кристаллах TlInS2

Madatov R., Наджафов А., Мамедов Вугар, Mamedov M

Институт радиационных проблем НАН Азербайджана

Электронная обработка материалов

Nr. 2(46) / 2010 / ISSN 0013-5739 / ISSNNe 2345-1718

Disponibil online 31 March, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-799

Механизм токопрохождения в монокристаллах TlInSe2 при сильных электрических полях

Madatov R., Наджафов А., Tagiev T., Gazanfarov M.

Институт радиационных проблем НАН Азербайджана

Электронная обработка материалов

Nr. 5(46) / 2010 / ISSN 0013-5739 / ISSNNe 2345-1718

Disponibil online 30 March, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-736